PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-012861

(43)Date of publication of application: 15.01.2002

(51)Int.CI.

CO9K 11/06 HOSB 33/14 BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number: 2000-200419

(71)Applicant:

TOYO INK MFG CO LTD

(22)Date of filing:

03.07.2000

(72)Inventor:

TOBA YASUMASA

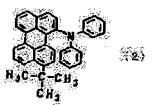
ONIKUBO SHUNICHI

(54) LUMINESCENT MATERIAL FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT PRODUCED BY USING THE LUMINESCENT MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic EL element having good luminescence color, high luminance/efficiency of luminescence and long life and provide a luminescent material for an organic EL element satisfying the above properties.

SOLUTION: The luminescent material for an organic electroluminescence element is a perylene derivative of general formula (1) having one ore more substituted or unsubstituted amino groups on the 1 or 2-position of a perylene skeleton. The compound of formula (2) is a concrete example of the compound of general formula (1).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(51) Int.Cl.7

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-12861 (P2002-12861A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成14年1月15日(2002.1.15)

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

CA05 CB01 CB03 DA00 DB03

ンキ製造株式会社内 Fターム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB03 AB04 CA01

_			, 1 (D-1)
C09K 11/06	620	C09K 11/06	620 3K007
	6 2 5		6 2 5
	6 3 5		6 3 5
	690		690
H05B 33/14		H 0 5 B 33/14	В
	審査請求	未請求 請求項の数10 (DL (全 28 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-200419(P2000-200419)	(71)出顧人 000222118	3
		東洋イン	丰製造株式会社
(22)出顧日	平成12年7月3日(2000.7.3)		央区京橋2丁目3番13号
		(72)発明者 鳥羽 泰正	
		東京都中央	央区京横二丁目3番13号 東洋イ
			朱式会社内
		(72)発明者 鬼久侵 4	2

FΙ

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料およびそれを使用した有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

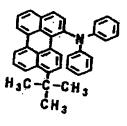
(修正有)

識別記号

【課題】良好な発光色、高い発光輝度/効率、長寿命の 有機EL素子と、それを満たす有機EL素子用発光材料 を提供する。

【解決手段】ペリレン骨格の1位もしくは2位に少なくとも一つ以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有する一般式1のペリレン誘導体である有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

一般式1の化合物の具体例には次のものがある。



EBOO FA01

【特許請求の範囲】

【請求項1】ペリレン骨格の1位もしくは2位に少なくとも一つ以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン誘導体であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

1

【請求項2】ペリレン骨格の1位に少なくとも一つ以上 の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン誘導 体であることを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

2

【請求項3】ペリレン誘導体が、下記一般式[1]で表される化合物であることを特徴とする請求項2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

一般式[1]

【化1】

[式中、 $R^1 \sim R^8$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲ ン原子、シアノ基、ニトロ基、置換もしくは未置換のア ルキル基、置換もしくは未置換のアルコキシ基、置換も しくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換 のアルキルチオ基、置換もしくは未置換のアリールチオ 基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未 置換の芳香族複素環基、または、置換もしくは未置換の アミノ基であり、R1~R1の内、少なくとも一つは置換も しくは未置換のアミノ基である。R⁹~R¹² は、それぞれ 独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未 置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換のアリールオ キシ基、置換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換も しくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換の アリール基、または置換もしくは未置換の芳香族複素環 基であり、R1~R12は、隣り合う2つの置換基同士で結 合して環を形成していても良い。]

【請求項4】 R⁹~R¹² が、全て水素原子となることはないことを特徴とする請求項3記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

【請求項5】R¹およびR²の少なくとも一つと、R³およびR⁴の少なくとも一つとが、置換もしくは未置換のアミノ基であることを特徴とする請求項3または4記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

【請求項6】置換もしくは未置換のアミノ基が、下記一般式[2]であることを特徴とする請求項1~5いずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。

一般式 [2]

【化2】

[式中、Ar¹およびAr²は、炭素数6~30のアリール基である。]

【請求項7】更に正孔注入材料もしくは電子注入材料を 含んでなる請求項1ないし6いずれか記載の有機エレク トロルミネッセンス素子用発光材料。

【請求項8】陽極と陰極とからなる一対の電極間に少なくとも一層の発光層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層が請求項1ないし7いずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】さらに、発光層と陰極との間に少なくとも 一層の電子注入層を形成してなる請求項8記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】陽極と陰極とからなる一対の電極間に発光層または、発光層並びに電子注入層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層が請求項1ないし7いずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層であり、発光層または電子注入層が下記一般式[3]で示される化合物を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子。

一般式 [3]

50 【化3】

Q¹
Ga—L
Q²

3

[式中、Q¹およびQ²は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換のヒドロキシキノリン誘導体または置換もしくは未置換のヒドロキシベンゾキノリン誘導体を表し、Lは、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアリール基、または、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリール基、または、置換もしくは未置換のアリール基、または、置換もしくは未置換のアリール基、または、置換もしくは未置換の芳香族複素環基を表す。)、一〇一Ga-Q³(Q⁴)(Q³およびQ⁴は、Q¹およびQ²と同じ意味を表す。)で表される配位子を表す。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平面光源や表示に使用される有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子用発光材料およびそれを用いた有機EL素子に関する。さらに詳しくは、高輝度、高効率、長寿命を有し、黄色から赤色の発光を得るための有機EL素子用発光材料およびそれを用いた有機EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体発 光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL素 子は、発光層および該層をはさんだ一対の対向電極から 構成されている。発光は、両電極間に電界が印加される と、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入 され、この電子が発光層において正孔と再結合し、エネ ルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギー を光として放出する現象である。

【0003】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。近年、10V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率

を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL 素子が報告され、関心を集めている(アプライド・フィジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年 参照)。この方法は、金属キレート錯体を発光層、アミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光を得ており、 $6\sim10\,\mathrm{V}$ の直流電圧で輝度は数 $1000\,\mathrm{C}$ ($\mathrm{cd/m^2}$)、最大発光効率は $1.5\,\mathrm{(1m/W)}$ を達成して、実用領域に近い性能を持っている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術に述べた有機E L 素子は、構成の改善により発光強度は改良されているものの、未だ充分な発光輝度を有しているとはいえない。また、繰り返し使用時の安定性に劣るという大きな問題を持っている。これは、例えば、トリス(8ーヒドロキシキノリナート)アルミニウム錯体等の金属キレート錯体が、電界発光時に化学的に不安定となり、陰極との密着性も悪いため、短時間の発光で劣化することによる。以上の理由により、良好な発光色と、高い発光輝度、発光効率を示し、さらに長い寿命を持つ有機E L 素子と、それを満足しうる有機E L 素子用発光材料が求められていた。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、以上の諸 問題を考慮し解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明 に至った。

【0006】すなわち、本発明は、ペリレン骨格の1位もしくは2位に少なくとも一つ以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン誘導体であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関する。

【0007】また、本発明は、ペリレン骨格の1位に少なくとも一つ以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン誘導体であることを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関する。

【0008】また、本発明は、ペリレン誘導体が、下記一般式[1]で表される化合物であることを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関する。

一般式[1]

[0009]

【化4】

$$R^{5}$$
 R^{1} R^{2} R^{6}
 R^{9} R^{10} R^{10} R^{7} R^{3} R^{4} R^{8}

[式中、R1~R8は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲ ン原子、シアノ基、ニトロ基、置換もしくは未置換のア 」ルキル基、置換もしくは未置換のアルコキシ基、置換も しくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換 のアルキルチオ基、置換もしくは未置換のアリールチオ 基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未 置換の芳香族複素環基、または、置換もしくは未置換の 20 アミノ基であり、R1~R1の内、少なくとも一つは置換も しくは未置換のアミノ基である。R⁹~R¹²は、それぞれ 独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ 基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未 置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換のアリールオ キシ基、置換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換も しくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換の アリール基、または置換もしくは未置換の芳香族複素環 基であり、 $R^1 \sim R^{12}$ は、隣り合う2つの置換基同士で結 合して環を形成していても良い。]

5

また、本発明は、R⁹~R¹²が、全て水素原子となることはないことを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関する。

【0010】また、本発明は、R¹およびR²の少なくとも一つと、R³およびR⁴の少なくとも一つとが、置換もしくは未置換のアミノ基であることを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関する。

【0011】また、本発明は、置換もしくは未置換のアミノ基が、下記一般式[2]であることを特徴とする上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関す 40る。

一般式 [2]

[0012]

【化5】

6

[式中、Ar¹およびAr²は、炭素数6~30のアリール基である。]

また、本発明は、更に正孔注入材料もしくは電子注入材料を含んでなる上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に関する。

【0013】また、本発明は、陽極と陰極とからなる一対の電極間に少なくとも一層の発光層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0014】また、本発明は、さらに、発光層と陰極との間に少なくとも一層の電子注入層を形成してなる上記 有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【0015】また、本発明は、陽極と陰極とからなる一対の電極間に発光層または、発光層並びに電子注入層を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層が上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層であり、発光層または電子注入層が下記一般式[3]で示される化合物を含有する層である有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

一般式 [3]

[0016]

【化6】

[式中、 Q^1 および Q^2 は、それぞれ独立に、置換もしく は未置換のヒドロキシキノリン誘導体または置換もしく は未置換のヒドロキシベンゾキノリン誘導体を表し、L は、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、 置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは 未置換のアリール基、または、置換もしくは未置換の芳 香族複素環基、一OR(Rは水素原子、置換もしくは未 置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキ ル基、置換もしくは未置換のアリール基、または、置換 もしくは未置換の芳香族複素環基を表す。)、一〇一G $a-Q^3$ (Q^4) (Q^3 および Q^4 は、 Q^1 および Q^2 と同 じ意味を表す。)で表される配位子を表す。]

【発明の実施の形態】以下、詳細にわたって本発明を説

明する。まずはじめに、本発明の有機EL素子用発光材

料について説明する。本発明の有機EL素子用発光材料

[0017]

〔発明の詳細な説明〕

[0018]

は、ペリレン骨格の1位もしくは2位に少なくとも一つ 以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン 誘導体であるという特徴を有する。ここで、ペリレン骨 格の1位もしくは2位という意味は、化学大辞典編集委 30 員会編、「化学大辞典縮刷版」、第8巻、第400頁 (1964年共立出版株式会社発行) 記載のペリレン (perylene) の項で記載されている位置に準拠 するものであるが、ペリレン骨格の当該記載の6位、 7 位、12位も本発明でいう1位に含まれる。同様、5 位、8位、11位も発明でいう2位に含まれる。本発明 のペリレン誘導体は、ペリレン骨格の1位、2位、5 位、6位、7位、8位、11位、12位のいずれかに少 なくとも一つ以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有

【0019】次に、本発明の有機EL素子用発光材料が 有用である理由を説明する。まず、ペリレン骨格の1位 もしくは2位に少なくとも一つ以上の置換もしくは未置 換のアミノ基を有する場合、ペリレン骨格を成す面と置 換もしくは未置換のアミノ基が成す面との角度(二面 角)が0°ではなくなるために(即ち、同一面上から捻 れるため)、ペリレン誘導体が立体的な構造をとると考 えられる。その結果、ペリレン誘導体の分子同士による 濃度消光が起こりにくくなると共に、発光層のアモルフ

するペリレン誘導体を意味する。

寿命の発光素子が得られたと考えられる。これらペリレ ン誘導体は、化学構造の異なるペリレン誘導体同士の二 種以上の混合物として用いても良い。

【0020】また、本発明の有機EL素子用発光材料 は、好ましくは、ペリレン骨格の1位に少なくとも一つ 以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン 誘導体であり、さらに、ペリレン誘導体が、一般式

[1] で表される化合物であることがより一層好まし い。この理由は、置換もしくは未置換のアミノ基が、ペ リレン骨格の2位に結合している場合よりも1位に結合 している場合の方が、上述した二面角の角度がより大き くなり、その結果、ペリレン誘導体が、より立体的な構 造をとると考えられるためである。

【0021】ここで、一般式 [1] 中の置換基について 説明する。一般式 [1] 中の置換基R1~R8としては、 水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換も しくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアル コキシ基、置換もしくは未置換のアリールオキシ基、置 換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換もしくは未置 換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリール 基、置換もしくは未置換の芳香族複素環基、置換もしく は未置換のアミノ基をあげることができる。

【0022】ここで、ハロゲン原子としては、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子があげられる。

【0023】また、置換もしくは未置換のアルキル基と しては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、 secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、 ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステアリル基と いった炭素数1~30の未置換のアルキル基や、2-フ エニルイソプロピル基、トリクロロメチル基、トリフル オロメチル基、ベンジル基、αーフェノキシベンジル 基、 α , α – ジメチルベンジル基、 α , α – メチルフェ ニルベンジル基、α, α-ビス (トリフルオロメチル) ベンジル基、トリフェニルメチル基、αーベンジルオキ シベンジル基等の炭素数1~30の置換アルキル基があ げられる。

【0024】また、置換もしくは未置換のアルコキシ基 としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブ トキシ基、tert-ブトキシ基、オクチルオキシ基、 tertーオクチルオキシ基といった炭素数1~20の 未置換のアルコキシ基や、3、3、3ートリフルオロエ トキシ基、ベンジルオキシ基といった炭素数1~20の 置換アルコキシ基があげられる。

【0025】また、置換もしくは未置換のアリールオキ シ基としては、フェノキシ基、4-tert-ブチルフ エノキシ基、1ーナフチルオキシ基、2ーナフチルオキ シ基、9-アンスリルオキシ基といった炭素数6~20 の未置換のアリールオキシ基や、4ーニトロフェノキシ 基、3-フルオロフェノキシ基、ペンタフルオロフェノ ァス性を長期間保持でき、よって、高輝度、高効率で長 50 キシ基、3ートリフルオロメチルフェノキシ基等の炭素

数6~20の置換アリールオキシ基があげられる。

【0026】また、置換もしくは未置換のアルキルチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、tertープチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基といった炭素数1~20の未置換のアルキルチオ基や、1,1,1-テトラフルオロエチルチオ基、ベンジルチオ

1, 1-テトラフルオロエチルチオ基、ベンジルチオ 基、トリフルオロメチルチオ基といった炭素数1~20 の置換アルキルチオ基があげられる。

【0027】また、置換もしくは未置換のアリールチオ基としては、フェニルチオ基、2ーメチルフェニルチオ基、4ーtertープチルフェニルチオ基といった炭素数6~20の未置換のアリールチオ基や、3ーフルオロフェニルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基、3ートリフルオロメチルフェニルチオ基等の炭素数6~20の置換アリールチオ基があげられる。

【0028】また、置換もしくは未置換のアリール基としては、フェニル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、2,4ーキシリル基、pークメニル基、メシチル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアセナフチル基、2ーアズレニル基、1ーピレニル基、2ートリフェニレル基等の炭素数6~30の未置換のアリール基や、pーシアノフェニル基、pージフェニルアミノフェニル基、pースチリルフェニル基、4ー[(2ートリル)エテニル]フェニル基、4ー[(2,2ージトリル)エテニル]フェニル基等の炭素数6~30の置換アリール基があげられる。

【0029】また、置換もしくは未置換の芳香族複素環 基としては、2ーフリル基、3ーフリル基、2ーチエニ ル基、3-チエニル基、1-ピローリル基、2-ピロー リル基、3ーピローリル基、2ーピリジル基、3ーピリ ジル基、4-ピリジル基、2-ピラジル基、2-オキサ ゾリル基、3-イソオキサゾリル基、2-チアゾリル 基、3ーイソチアゾリル基、2ーイミダゾリル基、3ー ピラゾリル基、2ーキノリル基、3ーキノリル基、4ー キノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキ ノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、2-ベンゾフリル基、2-ベンゾチ エニル基、N-インドリル基、N-カルバゾリル基、N ーアクリジニル基といった炭素数3~20の未置換の芳 40 香族複素環基や、2-(5-フェニル)フリル基、2-(5-フェニル) チエニル基、2-(3-シアノ) ピリ ジル基といった炭素数3~20の置換芳香族複素環基が あげられる。

【0030】また、置換もしくは未置換のアミノ基としては、Nーメチルアミノ基、Nーエチルアミノ基、N, Nージエチルアミノ基、N, Nージイソプロピルアミノ基、N, Nージブチルアミノ基、N, Nージベンジルアミノ基、N, Nージベンジルアミノ基、N, Nージスンジルアミノ基、N, Nージスンジルアミノ基、N, Nージス 50

エニルアミノ基、N, Nービス(m-hリル)アミノ 基、N, Nービス(p-hリル)アミノ基、N, Nービス(p-hリル)アミノ基、N, Nービス(p-hリル)アミノ基、ビス [4-(4-x) チル)ビフェニリル]アミノ基、N-p-hリーフェニリルーNーフェニルアミノ基、N-p-hリルーNーフェニルアミノ基、N-フェナントリルーNーフェニルアミノ基等の炭素数 $1\sim30$ の未置換のアミノ基、N, Nービス(p-hアノフェニル)アミノ基、ビス [$4-(\alpha,\alpha'-i)$ メチルベンジル)フェニル]アミノ基等の炭素数 $1\sim30$ の置換アミノ基があげられる。

10

【0031】以上述べたR¹~R⁸の置換基の内、好ましいものとしては、水素原子、シアノ基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアメール基、置換もしくは未置換の方香族複素環基、置換もしくは未置換のアミノ基があげられ、より好ましいものとしては、水素原子、シアノ基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアミノ基があげられ、さらに好ましいものとしては、水素原子、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアミノ基があげられる。これら、R¹~R⁸は、隣り合う置換基同士で結合してアミノ基の窒素を含む環を形成していても良い。【0032】また、本発明の有機EL素子用発光材料は、G²11よいの数数の1位にからしました。

【0032】また、本発明の有機EL素子用発光材料は、好ましくは、ペリレン骨格の1位に少なくとも一つ以上の置換もしくは未置換のアミノ基を有するペリレン誘導体であり、さらに、ペリレン誘導体が、一般式

[1]で表される化合物であることがより一層好ましい。この理由は、置換もしくは未置換のアミノ基が、ペリレン骨格の2位に結合している場合よりも、1位に結合している場合の方が、上述した二面角の角度が大きくなり、ペリレン誘導体が、より立体的な構造をとると考えられるためである。

【0033】さらに、本発明の有機EL素子用発光材料は、前記一般式[1]において、R⁹~R¹²が全て水素原子となることはないペリレン誘導体であることが好ましいが、R⁹~R¹²が全て水素原子ではない場合、ペリレン誘導体の分子構造が、立体的により嵩高くなるためと考えられるからである。また、R¹およびR²の少なくとも一つとR³およびR⁴の少なくとも一つが置換もしくは未置換のアミノ基であるペリレン誘導体が、より好ましいが、この場合、ペリレン誘導体の特定位置に、二つの置換もしくは未置換のアミノ基を有することになるため、立体性を保持したまま、ペリレン誘導体自身のイオン化ポテンシャルが下がるためと考えられる。さらに、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料は、置換もしくは未置換のアミノ基が、一般式[2]の構造をとることが一層好ましい。

【0034】ここで、一般式 [2] 中の置換基 Ar^1 および Ar^2 としては、 $R^1 \sim R^8$ の置換基の説明で述べた

炭素数 6~30の置換もしくは未置換のアリール基があげられる。この内、好ましいアリール基としては、フェニル基、οートリル基、mートリル基、pートリル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーフェナントリル基があげられ、好ましい置換アリール基としては、pージフェニルアミノフェニル基、pースチリルフェニル基、4ー[(2,2ージトリル)エテニル]フェニル基、4ー[(2,2ージトリル)エテニル]フェニル基、4ー(α,α'ージメチルベンジル)フェニル基があげられる。

【0035】したがって、一般式[2]に該当する好ま しい置換もしくは未置換のアミノ基の例としては、N, N-ジフェニルアミノ基、N, N-ビス(2-メチルフ エニル) アミノ基、N, N-ビス (3-メチルフェニ ル) アミノ基、N, N-ビス (4-メチルフェニル) ア ミノ基、N, Nーピス (4 -エチルフェニル) アミノ 基、N, N-ビス (4-イソプロピルフェニル) アミノ 基、N, N-ビス (4-ブチルフェニル) アミノ基、 N, N-ビス (4-tert-ブチルフェニル) アミノ 基、N, N-ビス(2, 3-ジメチルフェニル)アミノ 20 基、N, Nービス (2, 4ーメチルフェニル) アミノ 基、N, N-ジ (1-ナフチル) アミノ基、N, N-ジ (2-ナフチル) アミノ基、N, N-ジ (9-フェナン トリル) アミノ基といった対称芳香族アミノ基、およ び、NーフェニルーNーoートリルアミノ基、Nーフェ ニルーN-m-トリルアミノ基、N-フェニル-N-p ートリルアミノ基、N-フェニル-N-2, 3-キシリ ルアミノ基、NーフェニルーNー2, 4ーキシリルアミ ノ基、N-フェニル-N-1-ナフチルアミノ基、N-フェニル-N-2-ナフチルアミノ基、N-フェニル- 30 N-9-フェナントリルアミノ基、N-フェニル-N-[4-(ジフェニルアミノフェニル)] アミノ基、N-フェニルーNー (4ースチリルフェニル) アミノ基、N ーフェニルーN- [4- [(2-トリル) エテニル] フ エニル] アミノ基、 $N-フェニル-N-[4-(\alpha,$ α'ージメチルベンジル)フェニル]アミノ基といった 対称芳香族アミノ基があげられる。

【0036】以下、表1に、本発明の有機EL素子用発 光材料として用いることができるペリレン誘導体の代表 例を示すが、本発明は、なんらこれらに限定されるもの 40 ではない(但し、表中、Phはフェニル基を、Tolは p-トリル基を表す)。

[0037]

【表1】

(2)

(2)

(3)

(4)

(b. # # # #

(c. # # # # #

(c. # # # #

(c. # # # #

(c. # # # # # #

(c. # # # # #

(c. # # # # # # # # #

(c. # # # # # #

(c. # # # # # #

(c. # # # # # # #

(c. # # # # # #

(c. # # # # # #

(c. # # # # # # #

(c. # # # # # # #

(c. # # # # # # #

(

12

[0038]

20

13

	化 学 構 造
(8)	SCH;
(6)	SPh OCH;
(7)	Ph CH ₃
(8)	H3C ()

(10)

(10)

(11)

(11)

(11)

(11)

(12)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

[0039]

[0040]

(12)

15

	化 学 構 造
(13)	H ₃ C −C −C N
(14)	Ph ₂ N-C-N-N-CH ₃
(15)	H ₃ C-_N
(16)	H ₃ COOCH ₃

(18) PhO (18) PhO (19) CH3 (20) Ph

[0041]

[0042]

	化 学 構 造
(21)	Ph CH ₃
(22)	Ph H ₃ C N CH ₃
(23)	Tol Tol
(24)	Tol N

化 学 構 達 H₃CO N

18

10

20

(26) NPh2

(27) SS CH₃

(28) Ph CH3

[0043]

[0044]

20

30

19

	化 学 構 造
(29)	Ph CH3
(30)	S N S N P N P N P N P N P N P N P N P N
(31)	Tol ₂ N NTol ₂
(32)	Tol ₂ N NTol ₂

[0045]

[0046]

20

30

21

	化 学 構 造
(37)	Tol2N NTol2 Tol2N NTol2
(38)	Tol ₂ N NTol ₂
(39)	NTol ₂ CH ₂ Ph Tol ₂ N
(40)	NTOI ₂ CH ₃ Toi ₂ N

22

[0047]

[0048]

20

23

	化 学 構 造
(45)	Tol ₂ N OH ₃
(46)	Tol ₂ N NTol ₂
(47)	PhH ₂ C NTol ₂ Tol ₂ N Ph
(48)	Ph Ph

(50) Ph Tol₂N NTol₂ Olymph (51) H₃C Tol₂N NTol₂ S CN Ph Tol₂N

[0049]

[0050]

25

	化学構造
(53)	Tol2N NTol2
(54)	NTOI2 NC -NPh2
(65)	H ₃ C CH ₃
(56)	CN CN

[0051]

(57)

Ph — C — CH₃

CH₃ Ph Ph — C — CH₃

CH₃ Ph Ph — CH₃

CH₃ Ph Ph — CH₃

(58)

PhO₂S Ph Ph — SO₂Ph

PhO₂S Ph Ph SO₂Ph

(50)

[0052]

	化 学 構 造
(61)	H ₃ C Ph
(62)	H ₃ C Ph CH ₃
(63)	Ph Ph CH3

作 学 構 造

H₃C Ph Ph
Ph Ph
Ph Ph
CH₃

[0053]

30 [0054]

29

	化学構造
(67)	H ₃ C CH ₃ CH ₃
(68)	H;c CH; CH; CH;
(69)	H ₃ C CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃

(7 2) H₃C (7 2

[0055]

[0056]

20

30

31

	化学構造
(73)	H ₃ C CH ₃ NTol ₂
(74)	Ph CH ₃ H ₃ C C
(75)	Ph-
(76)	Tol-O-ON

作学構造

Ph Ph NTol2

(78)

Tol2N NTol2

Tol2N Ph NTol2

(80)

NTol2

NTol2

NTol2

NTol2

32

[0057]

[0058]

33

	化 学 構 造
(81)	NTol ₂
(82)	N CH3
(83)	
(84)	

化学株造
Tol₂N NTol₂
(86) Tol₂N NTol₂

Tol2N NTol2

(87) Tol2N NTol2

(88) Tol2N NTol2

[0059]

[0060]

20

30

35

	化学構造
(89)	NTol ₂
(90)	H ₃ C - CH ₃
(91)	
(92)	

作学構造

Tol₂N NTol₂

(94) Tol₂N NTol₂

(95) NTol₂

NTol₂ NTol₂

[0061]

[0062]

20

	化 学 構 造
(97)	Tol ₂ N NTol ₂
(98)	NPh ₂ NTol ₂
(89)	Tol ₂ N NTol ₂
(100)	Tol ₂ N NTol ₂

[0063]

38

【0064】ところで、有機EL素子は、陽極と陰極間に一層または多層の有機薄膜を形成した素子であるが、ここで、一層型有機EL素子は、陽極と陰極との間に発光材料からなる発光層を有する。一方、多層型有機EL素子は、(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)等の多層構成で積層した有機EL素子である。本発明の有機EL素子用発光材料は、これら一層型ないし多層型有機EL素子の発光材料は、これら一層型ないし多層型有機EL素子の発光材料として好適に使用することができる。特に、本有機EL素子用発光材料を用いて一層型有機EL素子を作成する場合、陽極から注入した正孔または陰極から注入した電子を発光材料まで効率よく輸送させるための正孔注入材料または電子注入材料を含有させることができる。

【0065】ここで、正孔注入材料とは、発光層または発光材料に対して優れた正孔注入効果を示し、発光層で生成した励起子の電子注入層または電子注入材料への移動を防止し、かつ薄膜形成性に優れた化合物を意味する。そのような正孔注入材料の例としては、フタロシアニン系化合物、ナフタロシアニン系化合物、ポルフィリン系化合物、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピラゾリ

ン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジン型トリフェニルアミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導体、およびポリビニルカルバゾール、ポリシラン、導電性ポリマー等があげられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0066】上記正孔注入材料の中でも特に効果的な正 孔注入材料としては、芳香族三級アミン誘導体またはフ タロシアニン誘導体があげられる。芳香族三級アミン誘 導体としては、トリフェニルアミン、トリトリルアミ ン、トリルジフェニルアミン、N, N'ージフェニルー N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェ ニル-4, 4' -ジアミン、N, N, N', N'- (4 _ ーメチルフェニル) -1, 1'-フェニルー4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'- (4-メチルフェニ ル) -1, 1'ービフェニル-4, 4'ージアミン、 $N, N' - \Im J = -N, N' - \Im J = -1,$ 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、N, N'-(メチルフェニル) -N, N' - (4-n-ブチルフェ ニル) -フェナントレン-9, 10-ジアミン、N, N ービス (4-ジー4-トリルアミノフェニル) -4-フ エニルーシクロヘキサン、またはこれらの芳香族三級ア ミン骨格を有するオリゴマーまたはポリマーがあげられ る。また、フタロシアニン (Pc) 誘導体としては、H 2 Pc, CuPc, CoPc, NiPc, ZnPc, P dPc, FePc, MnPc, ClAlPc, ClGa Pc, ClinPc, ClSnPc, Cl2SiPc, (HO) AlPc, (HO) GaPc, VOPc, Ti OPc、MoOPc、GaPc-O-GaPc等のフタ ロシアニン誘導体およびナフタロシアニン誘導体があげ られる。以上述べた正孔注入材料は、更に電子受容材料 を添加して増感させることもできる。

【0067】一方、電子注入材料とは、発光層または発光材料に対して優れた電子注入効果を示し、発光層で生成した励起子の正孔注入層または正孔注入材料への移動を防止し、かつ薄膜形成性に優れた化合物を意味する。そのような電子注入材料の例としては、キノリン金属錯体、オキサジアゾール、ベンゾチアゾール金属錯体、ベンゾオキサゾール金属錯体、ベンゾイミダゾール金属錯体、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオピランジオキシド、オキサジアゾール、チアジアゾール、テトラゾール、ペリレンテトラカルボン酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、アントロン等とそれらの誘導体があげられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0068】上記電子注入材料の中でも特に効果的な電子注入材料としては、金属錯体化合物または含窒素五員環誘導体があげられる。ここで、金属錯体化合物の中で 50

も、特に、一般式[3]で示される化合物は好適に使用することができる。

【0069】ここで一般式 [3] について説明する。一般式 [3] で示される化合物のQ¹~Q⁴は、置換もしくは未置換のヒドロキシキノリン誘導体または置換もしくは未置換のヒドロキシベングキノリン誘導体である。ここで置換基としては、一般式 [1] のR¹~R®の説明で示したハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアミノ基をあげることができる。

【0070】また、Lは、ハロゲン原子、置換もしくは 未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアル キル基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしく は未置換の芳香族複素環基を表す。ここで、置換もしく は未置換のシクロアルキル基としては、シクロペンチル 基、シクロヘキシル基、シクロペプチル基、シクロオク チル基、シクロノニル基、シクロデカニル基等をあげる ことができる。ここでいう置換基としては、一般式

[1]の説明で示したハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換のアリールオキシ基、置換もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の芳香族複素環基、置換もしくは未置換のアミノ基をあげることができる。

【0071】したがって、一般式[3]で示される化合 物の具体例としては、ビス(2-メチル-8-ヒドロキ シキノリナート) (1-ナフトラート) ガリウム錯体、 ビス (2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート) (2 ーナフトラート) ガリウム錯体、ビス (2ーメチルー8 ーヒドロキシキノリナート) (フェノラート) ガリウム 錯体、ビス(2ーメチルー8ーヒドロキシキノリナー ト) (4-シアノ-1-ナフトラート) ガリウム錯体、 ビス (2、4-ジメチル-8-ヒドロキシキノリナー ト) (1-ナフトラート) ガリウム錯体、ビス (2、5 ージメチルー8ーヒドロキシキノリナート) (2ーナフ トラート)ガリウム錯体、ビス(2-メチル-5-フェ ニルー8ーヒドロキシキノリナート) (フェノラート) ガリウム錯体、ビス (2-メチルー5-シアノー8-ヒ ドロキシキノリナート) (4-シアノ-1-ナフトラー ト) ガリウム錯体、ビス (2-メチル-8-ヒドロキシ キノリナート) クロロガリウム錯体、ビス (2-メチル -8-ヒドロキシキノリナート) (o-クレゾラート) ガリウム錯体等があげられるが、本発明はこれらに限定 されるものではない。尚、これら一般式[3]で示され る化合物は、特開平10-88, 121号公報記載の方

法により合成することが可能である。

【0072】その他、本発明に使用可能な電子注入材料 の内、好ましい金属錯体化合物としては、8-ヒドロキ シキノリナートリチウム、ビス (8-ヒドロキシキノリ ナート) 亜鉛、ビス (8-ヒドロキシキノリナート) 銅、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)マンガン、ト リス (8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム、ト リス (2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート) アル ミニウム、トリス (8-ヒドロキシキノリナート) ガリ ウム、ビス (10-ヒドロキシベンソ [h] キノリナー 10 ト) ベリリウム、ビス (10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナート)亜鉛等があげられる。

【0073】また、本発明に使用可能な電子注入材料の 内、好ましい含窒素五員誘導体としては、オキサゾー ル、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールま たはトリアゾール誘導体があげられ、具体的には、2, 5ービス (1ーフェニル) -1, 3, 4ーオキサゾー ル、ジメチルPOPOP、2,5-ビス(1-フェニ ル) -1, 3, 4ーチアゾール、2, 5ービス (1ーフ エニル) −1, 3, 4−オキサジアゾール、2− (4' -tert-ブチルフェニル) -5-(4" -ビフェニ ル) 1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス (1 ーナフチル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、1, 4 ービス [2-(5 ーフェニルオキサジアゾリル)] ベン ゼン、1, 4ービス [2-(5-フェニルオキサジアゾ リル)-4-tert-ブチルベンゼン]、2-(4' -tert- ブチルフェニル) -5-(4" -ビフェニ (μ) - 1, 3, 4 - チアジアゾール、2, 5 - ビス (1) ーナフチル) -1, 3, 4-チアジアソール、1, 4-ビス [2-(5-フェニルチアジアゾリル)] ベンゼン、 $2-(4'-tert-7\pi\nu)-5-(4"$ ービフェニル)-1,3,4-トリアゾール、2,5-ビス(1ーナフチル)-1, 3, 4ートリアゾール、 1, 4ービス [2-(5-フェ ニルトリアゾリル)] ベ ンゼン等があげられる。以上述べた電子注入材料は、更 に電子供与性材料を添加して増感させることもできる。 【0074】また、本発明の有機EL素子用発光材料 は、発光層中にドーピングして使用することも可能であ る。この場合、本有機EL素子用発光材料は、以下に説 明するホスト材料に対して0.001~50重量%の範 囲で含有されることが好ましく、更には0.01~10 重量%の範囲で含有されることがより好ましい。

【0075】本発明の有機EL素子用発光材料と共に使 用できるホスト材料としては、キノリン金属錯体、ベン ゾキノリン金属錯体、ベンゾオキサゾール金属錯体、ベ ンゾチアゾール金属錯体、ベンゾイミダゾール金属錯 体、ベンソトリアゾール金属錯体、イミダゾール誘導 体、オキサジアゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、 トリアゾール誘導体等の電子輸送性材料。または、スチ

ェニルアミン誘導体、スチリルアミン型トリフェニルア ミン誘導体、ジアミノアントラセン型トリフェニルアミ ン誘導体、ジアミノフェナントレン型トリフェニルアミ ン誘導体等の正孔輸送性材料、およびポリビニルカルバ ゾール、ポリシラン等の導電性高分子の高分子材料等が あげられる。

42

【0076】また、本有機EL素子における発光層中に は、本発明の有機EL素子用発光材料の他に、他の発光 材料やドーピング材料を二種類以上組み合わせて使用す ることもできる。本発明の有機EL素子用発光材料と共 に使用できる他の発光材料やドーピング材料としては、 アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、 テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペ リレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペリノ ン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルブ タジエン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、オキ サジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビ ススチリル、ピラジン、シクロペンタジエン、キノリン 金属錯体、アミノキノリン金属錯体、イミン、ジフェニ ルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾー ル、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、 イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリ ドン、ルブレン等およびそれらの誘導体があげられる。 【0077】本有機EL素子における発光層中には、本 発明の有機EL素子用発光材料の他に、必要に応じて、 他の発光材料やドーピング材料のみならず、先に述べた 正孔注入材料や電子注入材料を二種類以上組み合わせて 使用することもできる。また、正孔注入層、発光層、電 子注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形成され ても良い。

【0078】さらに、本発明の有機EL素子の陽極に使 用される導電性材料は、4 e Vより大きな仕事関数を持 つものが適しており、そのようなものとしては、炭素、 アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、 タングステン、銀、金、白金、パラジウム等およびそれ らの合金、ITO基板、NESA基板と称される酸化ス ズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフ ェンやポリピロール等の有機導電性ポリマーがあげられ

【0079】また、本発明の有機EL素子の陰極に使用 される導電性材料は、4 e Vより小さな仕事関数を持つ ものが適しており、そのようなものとしては、マグネシ ウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウ ム、リチウム、ルテニウム、マンガン等およびそれらの 合金があげられる。ここで、合金としては、マグネシウ ム/銀、マグネシウム/インジウム、リチウム/アルミ ニウム等が代表例としてあげられるが、これらに限定さ れるものではない。合金の比率は、調製時の加熱温度、 雰囲気、真空度により制御可能なため、適切な比率から ルベン誘導体、ブタジエン誘導体、ベンジジン型トリフ 50 なる合金が調製可能である。また、フッ化リチウム、フ

ッ化マグネシウム、フッ化カルシウムなどのフッ化物や 酸化リチウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウムなど の酸化物の薄膜を電子注入層と陰極となる金属間に挿入 しても効果がある。これら陽極および陰極は、必要があ れば二層以上の層構成により形成されていても良い。

【0080】本発明の有機EL素子を効率良く発光させ るためには、素子を構成する材料は素子の発光波長領域 において充分透明であることが望ましく、同時に基板も 透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性 材料を使用して蒸着やスパッタリング等の方法で作成す 10 ることができる。特に、発光面の電極は、光透過率を1 0%以上であることが望ましい。基板は、機械的、熱的 強度を有し、透明であれば特に限定されるものではない が、例えば、ガラス基板、ポリエチレン、ポリエーテル サルフォン、ポリプロピレン等の透明性ポリマーが推奨

【0081】また、本発明の有機EL素子の各層の形成 方法としては、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ、 イオンプレーティング等の乾式成膜法、もしくはスピン コーティング、ディッピング、フローコーティング等の 20 湿式成膜法のいずれかの方法を適用することができる。 各層の膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜 厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎると、一定の光 出力を得るために大きな印加電圧が必要となり効率が悪 くなる。逆に膜厚が薄すぎると、ピンホール等が発生 し、電界を印加しても充分な発光輝度が得ら難くなる。 したがって、通常の膜厚は、1 nmから $1 \mu m$ の範囲が 適しているが、10 nmから0. 2μmの範囲がより好 ましい。

【0082】湿式成膜法の場合、各層は、それを構成す 30 る材料をトルエン、クロロホルム、テトラヒドロフラ ン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解または分散して薄 膜を形成する。ここで用いられる溶媒は単一あるいは混 合したもののいずれでも構わない。また、いずれの湿式 成膜法においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等 のため適切なポリマーや添加剤を使用しても良い。この ようなポリマーとしては、ポリスチレン、ポリカーボネ ート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポ リウレタン、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレー ト、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性ポ 40 リマー、ポリーN-ビニルカルバゾール、ポリシラン等 の光導電性ポリマー、ポリチオフェン、ポリピロール等 の導電性ポリマーを挙げることができる。また、添加剤 としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等をあげ ることができる。

【0083】また、本発明により得られた有機EL素子 の温度、湿度、雰囲気等に対する安定性向上のために、 さらに素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイ ル、ポリマー等により素子全体を被覆しても良い。

材料を用いて作成した有機EL素子は、発光効率、最大 発光輝度等の特性を向上させることが可能である。ま た、本有機EL素子は、熱や電流に対して非常に安定で あり、さらには低い駆動電圧で実用的に使用可能の発光 輝度が得られるため、従来まで大きな問題であった劣化 も大幅に低下させることが可能である。故に、本有機E L素子は、壁掛けテレビ等のフラットパネルディスプレ イや平面発光体として、さらには、複写機やプリンター 等の光源、液晶ディスプレイや計器類等の光源、表示 板、標識灯等への応用が考えられる。

[0085]

【実施例】以下、実施例にて本発明を具体的に説明する が、本発明は下記実施例に何ら限定されるものではな

<u>合成例 1</u>

<u>化合物(1)(1-(N,N-ジフェニルアミノ)-1</u> 0-tert-ブチルペリレン) の合成方法

ニトロベンゼン20m1中に、1-アミノ-10-te r t ープチルペリレン5.0g、ヨードベンゼン6.9 g、水酸化ナトリウム0.74g、および酸化銅0.5 gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて50時間加熱撹 拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈 し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を濃縮した後、シリ カゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を 行ない、化合物(1)3.8gを得た。マススペクト ル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(1) の構造を確認した。

合成例2

<u>化合物(7)(1-(N, N-ジ(p-トリル)アミ</u> ノ) -10-フェニルペリレン)の合成方法 ニトロベンゼン20ml中に、1-アミノ-10-te r tーブチルペリレン5. 0g、pーヨードトルエン 7. 4g、水酸化ナトリウム 0. 74g、および酸化銅 0.5gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて50時間 加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で 希釈し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を濃縮した後、 シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精 製を行ない、化合物(7)3.7gを得た。マススペク トル、NMRスペクトルによる分析により、化合物 (7) の構造を確認した。

合成例3

<u>化合物(32)(4-フェニルーN¹, N¹, N⁷, N⁷-</u> テトラ (pートリル) ペリレンー1, 7ージアミン) の

ニトロベンゼン20m1中に、4ーフェニルペリレンー 1, 7-ジアミン5.0g、p-ヨードトルエン15. 2g、水酸化ナトリウム1.5g、および酸化銅1.0 gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて50時間加熱撹 拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈 【0084】以上述べたように、本有機EL素子用発光 50 し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を濃縮した後、シリ

カゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を 行ない、化合物 (32) 3.8 gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物 (3 2) の構造を確認した。

合成例4

<u>化合物(45)(4,10-ジメチル-N,N,N',N'-テトラ(p-トリル)ペリレン-1,7-ジアミン</u>)の合成方法

1,3-ジメチルー2-イミダゾリジノン50ml中に、1,7-ジプロモー4,10-ジメチルペリレン5.0g、N,N-ジ(p-トリル)アミン4.9g、炭酸カリウム2.4g、および銅粉0.2gを添加し、窒素雰囲気下、200℃で50時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈し、トルエンで抽出した。抽出液を濃縮して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(45)3.7gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(45)の構造を確認した。

合成例5

<u>化合物(48)(4,10-ジフェニル-N,N,N,N',N',-テトラ(p-トリル)ペリレン-1,7-ジアミン)の合成方法</u>

1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン50m1中に、1,7-ジブロモー4,10-ジフェニルペリレン5.0g、N,N-ジ(p-トリル)アミン3.9g、炭酸カリウム1.5g、および銅粉0.15gを添加し、窒素雰囲気下、200℃で50時間加熱撹拌した。 放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈し、トルエンで抽出した。抽出液を濃縮して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(48)3.3gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(48)の構造を確認した。

合成例6

<u>化合物(56)(6,12-ビス(N-ナフタレン-1</u> <u>-イル-N-フェニルアミノ)ペリレン-3,9-ジカ</u> ルボニトリル)の合成方法

6, 12-ビス(N-ナフタレン-1-イル-N-フェニル) アミノ] ペリレン-3, 9-ジアミン7.0g、濃塩酸7g、蒸留水100g、および10%-シアン化銅20gからなる溶液を加熱環流し、この混合物に、攪拌しながら2.5gの亜硝酸ナトリウムを20gの蒸留水20gに溶かした溶液を30分かけて添加した。放冷後、上記混合物をトルエンで抽出した。抽出液を濃縮して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(56)5.6gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(56)の構造を確認した。

<u>合成例</u> 7

化合物 (58) (3, 4, 9, 10-テトラフェニルペ リレン-N, N, N', N'-テトラ (p-トリル) ペ リレン-1, 7-ジアミン) の合成方法

46

1,3-ジメチルー2-イミダゾリジノン50m1中に、1,7-ジプロモー3,4,9,10-テトラフェニルペリレン4.8g、N,N-ジ(p-トリル)アミン2.9g、炭酸カリウム1.2g、および銅粉0.15gを添加し、窒素雰囲気下、200℃で52時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500m1の水で希釈し、トルエンで抽出した。抽出液を濃縮して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(58)3.1gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(58)の構造を確認した。

合成例8

化合物 (60) (1, 7-ビス (N-フェナントレン-9-イル-N-フェニルアミノ) ペリレン-3, 4, 9, 10-テトラカルボニトリルの合成方法

1,3-ジメチル-2-イミダソリジノン50ml中
20 に、1,7-ジブロモペリレン-3,4,9,10-テトラカルボニトリル4.0g、N-フェナントレン-9
ーイル-N-フェニルアミン4.6g、炭酸カリウム
1.6g、および銅粉0.20gを添加し、窒素雰囲気下、200℃で48時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈し、トルエンで抽出した。抽出液を濃縮して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(60)2.9gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(60)の構造を確認した。

<u>合成例 9</u>

化合物 (74) (2-ジ (m-トリル) アミノー4, 1 0-ジフェニルペリレンの合成方法

1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン50m1中に、2-プロモー4,10-ジフェニルペリレン5.0g、N,N-ジ(m-トリル)アミン2.3g、炭酸カリウム1.0g、および銅粉0.10gを添加し、窒素雰囲気下、200℃で37時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500m1の水で希釈し、トルエンで抽出した。抽出液を濃縮して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(74)4.2gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(74)の構造を確認した。合成例10

<u>化合物(81)(1-ジ(m-トリル)アミノペリレン)の</u>合成方法

ニトロベンゼン20ml中に、1-アミノペリレン5. 0g、m-ヨードトルエン9.0g、水酸化ナトリウム 1.2g、および酸化銅1.0gを加え、窒素雰囲気 下、200℃にて40時間加熱撹拌した。放冷後、上記 50 混合物を500mlの水で希釈し、酢酸エチルで抽出し た。抽出液を濃縮した後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物 (81) 5.8gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物 (81) の構造を確認した。合成例11

<u>化合物(86)(1, 7-ビス[ジ(p-トリル)アミ</u> <u>ノ] ペリレン)の合成方法</u>

ニトロベンゼン20m1中に、1,7ージアミノペリレン5.0g、pーヨードトルエン17.0g、水酸化ナトリウム2.5g、および酸化銅1.5gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて60時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500m1の水で希釈し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を濃縮した後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(86)6.8gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(86)の構造を確認した。

合成例12

<u>化合物(89)(2-ジ(p-トリル)アミノペリレン)の合成方法</u>

ニトロベンゼン20m1中に、2-アミノペリレン5.0g、p-ヨードトルエン9.0g、水酸化ナトリウム1.2g、および酸化銅1.0gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて42時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500m1の水で希釈し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を濃縮した後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(89)6.2gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(89)の構造を確認した。合成例13

化合物 (93) (2, 11-ビス [ジ (p-トリル) アミノ] ペリレン) の合成方法

ニトロベンゼン20ml中に、2,11ージアミノペリレン5.0g、pーヨードトルエン17.0g、水酸化ナトリウム2.5g、および酸化銅1.5gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて54時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を濃縮した後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物(93)6.4gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物(93)の構造を確認した。

合成例14

<u>化合物(96)(1,8-ビス[ジ(p-トリル)アミノ]ペ</u>リレン)の合成方法

ニトロベンゼン20ml中に、1,8-ジアミノペリレン5.0g、p-ヨードトルエン17.0g、水酸化ナトリウム2.5g、および酸化銅1.5gを加え、窒素雰囲気下、200℃にて58時間加熱撹拌した。放冷後、上記混合物を500mlの水で希釈し、酢酸エチル 50

で抽出した。抽出液を濃縮した後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製を行ない、化合物 (96) 6.2 gを得た。マススペクトル、NMRスペクトルによる分析により、化合物 (96) の構造を確認した。

48

【0086】以下に本発明の化合物を用いた実施例を示す。本例では、混合比は全て重量比である。また電極面積2mm×2mmの有機EL素子の特性を測定した。

【0087】実施例1

洗浄したITO電極付きガラス板上に、発光材料として表1の化合物(1)、2,5-ビス(1ーナフチル)-1,3,4-オキサジアゾール、ポリカーボネート樹脂(帝人化成:パンライトK-1300)を1:2:10の重量比でテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーティング法により膜厚100nmの発光層を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1(重量比)で混合した合金で膜厚150nmの電極を形成して有機EL素子を得た。この素子の発光特性は、直流電圧5Vでの発光輝度40(cd/ m^2)、最大発光輝度840(cd/ m^2)、発光効率0.32(lm/W)の黄橙色発光が得られた。

【0088】実施例2

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、N, N'ー(3ーメチルフェニル)ーN, N'ージフェニルー1, 1'ービフェニル-4, 4'ージアミン(TPD)を真空蒸着して膜厚20nmの正孔注入層を得た。次いで、表1の化合物(7)を蒸着し膜厚40nmの発光層を作成し、次いでトリス(8ーヒドロキシキノリナート)アルミニウム錯体(Alq3)を蒸着して膜厚30nmの電子注入層を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1(重量比)で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10-6 Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は直流電圧5Vでの発光輝度180(cd/m²)、最大発光輝度13500(cd/m²)、発光効率1.2(1m/W)の橙色発光が得られた。

【0089】実施例3

30

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表1の化合物 (32)を塩化メチレンに溶解させ、スピンコーティング法により膜厚50mmの正孔注入型発光層を得た。次いで、ビス(2ーメチルー8ーヒドロキシキノリナート)(1ーナフトラート)ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚40mmの電子注入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1(重量比)で混合した合金で膜厚100mmの電極を形成して有機EL素子を得た。電子注入層は10・6 Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直流電圧5Vでの発光輝度270(cd/m²)、最大発光輝度3600(cd/m²)、発光効率0.55(1m/ W)の橙色発光が得られた。

【0090】実施例4

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表1の化合物 (74)を真空蒸着して膜厚50nmの正孔注入型発光 層を得た。次いで、ビス(2ーメチルー8ーヒドロキシキノリナート)(pーシアノフェノラート)ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1(重量比)で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL素子を得た。発光層および電子注入層は10-6 Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素 10子は、直流電圧5Vでの発光輝度520(cd/m²)、最大発光輝度12600(cd/m²)、発光 効率1.3(1m/W)の黄橙色発光が得られた。【0091】実施例5~33 洗浄したITO電極付きガラス板上に 4 4'ービス

洗浄したITO電極付きガラス板上に、4,4'ービス[N-(1-ナフチル)ーN-フェニルアミノ]ビフェ

ニル (α-NPD) を真空蒸着して膜厚30nmの正孔注入層を形成した。次いで、発光材料として表1の材料を真空蒸着して膜厚30nmの発光層を得た。次いで、ビス (2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート) (フェノラート) ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1 (重量比) で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10-6 Torの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子の発光特性を表2に示す。ここでの発光輝度は、直流電圧5V印可時の輝度である。本実施例の有機EL素子は、全て最高輝度10000(cd/m²)以上の高輝度特性を有し、また、黄色~赤色までの発光色を得ることができた。

[0092]

【表	2]
----	---	---

実施例	表1の発光材料	発光輝度 (cd/m²)	最大発光輝度 (cd/m²)	最大発光効率 (Im/W)
5	(3)	580	12700	1. 3
6	(4)	590	15200	1. 4
7	(11)	480	16300	1. 6
8	(13)	750	19000	1. 8
9	(21)	590	15800	1. 7
10	(23)	680	17600	1. 7
11.	(27)	710	17700	1. 8
12	(33)	470	16600	1. 9
13	(39)	370	22800	2. 4
14	(44)	720	17200	1.8
15	(55)	760	13300	1. 4
16	(59)	880	19300	1. 8
17	(60)	730	13200	1. 4
18	(62)	970	14800	1. 6
19	(65)	480	17000	1. 7
20	(69)	230	16600	1. 8
21	(72)	870	23700	2. 2
22	(76)	390	14700	1.7
23	(77)	790	10900	1. 0
24	(80)	850	19400	1. 9
25	(81)	580	12500	1. 4
26	(84)	660	15800	1. 4
27	(86)	290	25900	2. 0
28	(88)	900	17400	1. 7
29	(89)	540	16300	1. 5
30	(93)	610	19500	1. 7
31	(96)	210	17000	1. 8
32	(100)	790	19200	1. 6
33	(102)	440	14700	1. 2

発光輝度は直流5V印加時の値

実施例34

洗浄した I T O 電極付きガラス板上に、4,4',4" ートリス [N-(3-メチルフェニル)-N-フェニル アミノ] トリフェニルアミンを真空蒸着して、膜厚40 n mの正孔注入層を得た。次いで、 $\alpha-NPD$ を真空蒸着して、膜厚10n mの第二正孔注入層を得た。さらに、表1の化合物(45)を真空蒸着して、膜厚30n 50

mの発光層を作成し、さらにビス(2ーメチルー8ーヒドロキシキノリナート)(フェノラート)ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成し、その上に、アルミニウムとリチウムを25:1(重量比)で混合した合金で膜厚150nmの電極を形成して、有機EL素子を得た。各層は10-6Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直流電

圧5 Vでの発光輝度 4 6 0 (c d/m²)、最大発光輝 度19700 (c d/m²)、発光効率2.1 (1m/ W)の橙色発光が得られた。

【0093】実施例35

洗浄したITO電極付きガラス板上に、4,4'ービス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニル(α-NPD)を真空蒸着して膜厚20nmの正孔 注入層を得た。次いで、表1の化合物 (56) を真空蒸 着し膜厚40nmの発光層を作成し、次いでトリス (8 ーヒドロキシキノリナート) アルミニウム錯体 (Ala 3)を蒸着して膜厚30nmの電子注入層を得た。その 上にまず、フッ化リチウム (LiF) を 0. 5 nm、さ らにアルミニウム(Al)を200nm真空蒸着によっ て電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10-6 T orrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。 この素子は直流電圧5Vでの発光輝度540 (cd/m `2) 、最大発光輝度22500(cd/m²)、発光効率 2. 5 (1 m/W) の橙色発光が得られた。

【0094】実施例36

ITO電極と表1の化合物 (58) の間に、銅フタロシ 20 アニンの膜厚 5 nmの正孔注入層を設ける以外は、実施 例3と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子 は、直流電圧5Vで発光輝度550(cd/m²)、最 大発光輝度13600 (c d/m²) 、発光効率1. 2 (1m/W) の赤橙色発光が得られた。

【0095】実施例37

4, 4', 4"-トリス[N-(3-メチルフェニル) -N-フェニルアミノ] トリフェニルアミンの代わりに 無金属フタロシアニンの膜厚20nmの正孔注入層を設 ける以外は、実施例34と同様の方法で有機EL素子を 作製した。この素子は、直流電圧5Vでの発光輝度28 0 (cd/m²)、最大発光輝度22800 (cd/ m²) 、発光効率 2.5 (1 m/W) の橙色発光が得ら れた。

【0096】実施例38

発光層として、表1の化合物(1)と(32)を2:3 の重量比率で蒸着した膜厚30mmの薄膜を設ける以外 は、実施例5と同様の方法で有機EL素子を作製した。 この素子は、直流電圧5Vでの発光輝度480(cd/ m²) 最大発光輝度14900 (cd/m²)、発光効率 40 1. 4 (1 m/W) の黄橙色発光が得られた。

【0097】実施例39

発光層として、表1の化合物(45)と(58)を1: 1の重量比率で蒸着した膜厚30nmの薄膜を設ける以 外は、実施例5と同様の方法で有機EL素子を作製し、 た。この素子は、直流電圧5Vでの発光輝度810(c d/m²) 最大発光 輝度19700 (cd/m²) 、発 光効率1.8(1m/W)の橙色発光が得られた。

【0098】実施例40

ンを真空蒸着して、膜厚50mmの正孔注入層を得た。 次いで、α-ΝΡDを真空蒸着して、膜厚30nmの第 二正孔注入層を得た。さらに、表1の化合物(48)を 真空蒸着して、膜厚30nmの発光層を作成し、さらに トリス (8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム錯 体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作成し、 その上に、アルミニウムとリチウムを25:1 (重量 比) で混合した合金で膜厚150nmの電極を形成し て、有機EL素子を得た。各層は10~Torrの真空 中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、 直流電圧5Vでの発光輝度480 (cd/m²)、最大 発光輝度29800 (c d/m²)、発光効率3.1 (1m/W) の橙色発光が得られた。また、この素子を 3 (mA/cm²) で連続発光させたところ、3000 時間以上安定した発光を観測できた。

52

【0099】比較例1

洗浄したITO電極付きガラス板上に、4,4'ービス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ピフェ ニル(α-NPD)を真空蒸着して膜厚30nmの正孔 注入層を形成した。次いで、発光材料として3,9-ビ ス(ジーpートリルアミノ)ペリレンを真空蒸着して膜 厚30nmの発光層を得た。次いで、ビス (2-メチル -8-ヒドロキシキノリナート) (フェノラート) ガリ ウム錯体を真空蒸着して膜厚30nmの電子注入層を作 成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1(重量 比)で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成して 有機EL素子を得た。各層は10-6 Torrの真空中 で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は、直 流電圧 5 V での発光輝度 3 5 0 (c d / m²)、最大発 光輝度18100 (cd/m²)、発光効率2.0 (1 m/W) の黄色発光が得られが、その発光面は斑が見ら れ、この素子を3(mA/cm^2)で連続発光させたと ころ、劣化が早く、約500時間後には殆ど光らなくな

【0100】比較例2

発光層として、3, 10-ビス (ジーp-トリルアミ ノ)ペリレンとトリス(8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム錯体(Ala3)を1:10の重量比率で 蒸着した膜厚30nmの薄膜を設ける以外は、比較例1 と同様の方法で有機EL素子を作製した。この素子は、 直流電圧5℃での発光輝度440(cd/m²)、最大 発光輝度16700 (cd /m²)、発光効率1.6 (1m/W)の黄色発光が得られたが、発光面上のムラ が大きかった。この素子を3(mA/cm^2)で連続発 光させたところ、劣化が早く、約500時間後にはムラ がさらに顕著になった。

【0101】本実施例で示された有機EL素子は、二層 型以上の素子構成において、最大発光輝度10000 (cd/m²)以上の発光が得られ、全て高い発光効率 洗浄したITO電極付きガラス板上に、銅フタロシアニ 50 を得ることができた。本実施例で示された有機EL素子

【発明の効果】本発明の有機EL素子用発光材料に用い

て作成した有機EL素子は、黄色から赤色まで発光し、

従来に比べて高い発光効率で高輝度であり、長い発光寿

命を持つため、壁掛けテレビ等のフラットパネルディス

プレイや平面発光体として好適に使用することができ、

故に、複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイ

や計器類等の光源、表示板、標識灯等への応用が可能で

について、 $3 (mA/cm^2)$ で連続発光させたところ、1000時間以上安定な発光を観測することができた。

【0102】本発明の有機EL素子は発光効率、発光輝度の向上と長寿命化を達成するものであり、併せて使用される発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料、電子注入材料、増感剤、樹脂、電極材料等および素子作製方法を限定するものではない。

[0103]

フロントページの続き

(51) Int .C1 .⁷

識別記号

H 0 5 B 33/22

FΙ

ある。

テーマコート* (参考)

H 0 5 B 33/22

В

D